

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-011 射頻濺鍍機)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 1 / 4 頁

一、目的：

定義射頻濺鍍機操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：

適用於射頻濺鍍機。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過射頻濺鍍機考核通過之人員。

四、名詞定義：

無

五、相關文件：

無。

六、標準作業程序：

(一) MES 控制系統開啟設備

1.1 於 MES 控制系統輸入帳號密碼(User ID / Password)



1.2 開啟設備射頻濺鍍機

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-011 射頻濺鍍機)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 2 / 4 頁

(二) 開機

- 2.1 開啟總電源、觸控面板。
- 2.2 開啟冷卻水閥、製程 Gas 閥。



(三) 製程

- 3.1 開啟觸控面板，點選畫面選取，進入到操作畫面。



NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-011 射頻濺鍍機)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 3 / 4 頁



3.2 點取 **VV** 破真空，直到 $7.5 \text{ E}+2 \text{ Torr}$ 後，才可開蓋將腔體打開。

3.3 試片放置完成後，將 O-ring 擦拭清潔後裝回，即可將上蓋放下關閉。

3.4 點取 **自動抽氣** 進行抽真空，等待真空度穩定至 $5.0 \text{ E}-6 \text{ Torr}$ (背景壓力)

3.5 至製程參數設定，設定 Power 功率、Gas 流量，鍍膜時間，確認製程參數設定正確常按載入參數即可。

3.6 跳回主畫面點取自動製程開始。

(四) 關機

4.1 製程完畢，Vent Chamber(確認 MV 關閉)

4.2 拿取試片，關閉腔體，抽真空至 $5.0 \text{ E}-6 \text{ Torr}$

4.3 關閉 Web 控制系統，填寫記錄本。

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-011 射頻濺鍍機)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 4 / 4 頁

七、應用表單及附件：

1. Q4-NL02 設備管理卡
 2. Q4-NL03 設備考核表
 3. Q4-NL04 設備點檢表
 4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單
-